

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4244315号  
(P4244315)

(45) 発行日 平成21年3月25日(2009.3.25)

(24) 登録日 平成21年1月16日(2009.1.16)

(51) Int.Cl.

G03F 7/11 (2006.01)  
H01L 21/027 (2006.01)

F 1

G03F 7/11 503  
H01L 21/30 574

請求項の数 5 (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2003-396335 (P2003-396335)  
 (22) 出願日 平成15年11月26日 (2003.11.26)  
 (65) 公開番号 特開2004-341479 (P2004-341479A)  
 (43) 公開日 平成16年12月2日 (2004.12.2)  
 審査請求日 平成18年2月7日 (2006.2.7)  
 (31) 優先権主張番号 特願2002-382898 (P2002-382898)  
 (32) 優先日 平成14年12月2日 (2002.12.2)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)  
 (31) 優先権主張番号 特願2003-116164 (P2003-116164)  
 (32) 優先日 平成15年4月21日 (2003.4.21)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000220239  
 東京応化工業株式会社  
 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地  
 (74) 代理人 100071825  
 弁理士 阿形 明  
 (74) 代理人 100095153  
 弁理士 水口 崇敏  
 (72) 発明者 平山 拓  
 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地  
 東京応化工業株式会社内  
 (72) 発明者 山田 知孝  
 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地  
 東京応化工業株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 レジストパターン形成用材料

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

下地基板とレジスト膜との間に反射防止膜を有するレジストパターン形成用材料において、反射防止膜が、(A)(a<sub>1</sub>)(ヒドロキシフェニルアルキル)シリセスキオキサン単位10~90モル%、(a<sub>2</sub>)(アルコキシフェニルアルキル)シリセスキオキサン単位0~50モル%及び(a<sub>3</sub>)フェニルシリセスキオキサン単位10~90モル%からなるラダー型シリコーン共重合体、(B)熱又は光により酸を発生する酸発生剤及び(C)架橋剤の有機溶剤溶液から形成された塗膜であって、0.002~0.95の範囲のArFレーザーに対する光学パラメーター(k値)を有するものであることを特徴とするレジストパターン形成用材料。

## 【請求項 2】

(A)成分、(B)成分及び(C)成分に加えて、さらに(D)線状ポリマーを含有する請求項1記載のレジストパターン形成用材料。

## 【請求項 3】

前記(D)線状ポリマーが、少なくとも水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル単位を含むポリマーである請求項2記載のレジストパターン形成用材料。

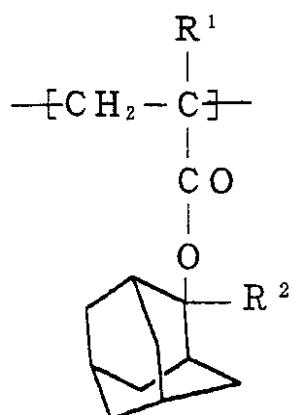
## 【請求項 4】

前記(D)線状ポリマーが、少なくとも水酸基含有脂肪族多環式基を有する(メタ)アクリル酸エステル単位を含むポリマーである請求項3記載のレジストパターン形成用材料。

## 【請求項 5】

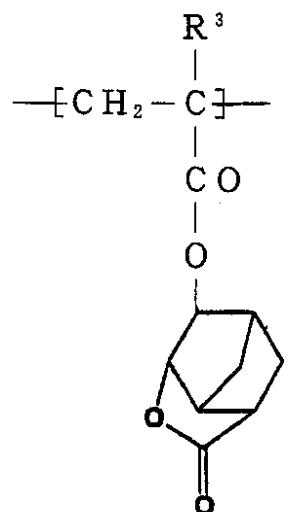
前記 (D) 線状ポリマーが、(d<sub>1</sub>) 一般式

## 【化 1】

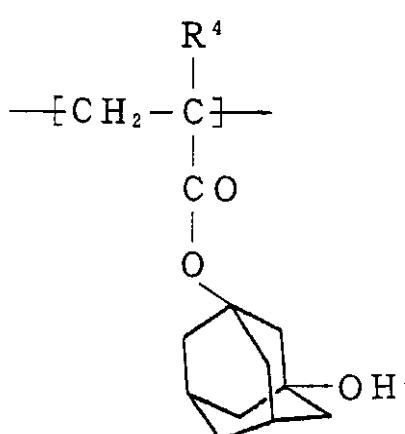


(式中、R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基、R<sup>2</sup>は低級アルキル基である)  
で表わされる構成単位 10 ~ 60 モル%、(d<sub>2</sub>) 一般式

## 【化 2】



(式中のR<sup>3</sup>は水素原子又はメチル基である)  
で表わされる構成単位 30 ~ 80 モル%、及び(d<sub>3</sub>) 一般式  
【化 3】



(式中、R<sup>4</sup>は水素原子又はメチル基である)  
で表わされる構成単位 10 ~ 50 モル% からなる線状共重合体である請求項 3 記載のレジ

ストパターン形成用材料。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、リソグラフィ工程により半導体デバイスを製造する場合に用いるレジスト材料において、下地基板とレジスト膜との間に設けるための反射防止膜を有するレジストパターン形成用材料に関するものである。

## 【背景技術】

## 【0002】

近年、半導体素子の微細化が進むとともに、その製造に用いられるリソグラフィ工程についてよりいっそうの微細化が求められるようになってきている。そして、一般に半導体製造に際しては、シリコンウエーハ、シリコン酸化膜、層間絶縁膜などの基板の上に、リソグラフィ技術を用いてレジストパターンを形成し、これをマスクとして基板をエッチングすることが行われているが、微細化のためにはレジストについて、微細なパターンを解像しつつ、しかも高い精度でのレジストパターン線幅の制御の実現が必要とされる。

10

## 【0003】

ところで、このことを実現しようとすれば、パターン形成の際にレジストに照射される放射線における、レジスト膜と下地基板との境界で起こる反射が重大な意味をもってくる。すなわち、レジスト膜と下地基板間で放射線の反射が起ると、レジスト中の放射線強度が変化する結果、レジストパターンの線幅が変動し、正確なパターンが得られなくなる。

20

## 【0004】

このような障害を抑制するために、レジストと下地基板との間に反射防止膜や保護膜などの被膜を設けることが行われているが、これらの被膜を構成する材料のエッティング速度は、レジストのそれと近似しているため、レジストパターンを転写するときに障害となる上に、これらの被膜を除去する際にレジストパターンの膜減りや形状が劣化するなどのトラブルを生じ、基板の加工精度を低下させるという欠点を伴う。

## 【0005】

また、十分なエッティング耐性を確保するためにレジスト膜の膜厚を大きくすることも行われているが、この膜厚をあまり大きくすると、レジストパターンの線幅とレジスト膜の厚さとのアスペクト比が高くなり、現像工程においてレジストパターン特にアイソレートパターンのパターン倒れや、露光工程におけるレジストの解像力低下を生じるという欠点がある。

30

## 【0006】

そのほか、レジスト膜と被膜すなわち下層有機層との間に、中間層を設ける三層レジストプロセスも行われており、この中間層については、その上で再現性のよいレジストパターンを良好な形態で形成させうこと、プラズマエッティングに対して高い耐性を有するとともに、下層有機層との間に高いプラズマエッティング選択性を有していること、アルカリ現像液に対し耐性を有することなどの特性が要求されることから、この要求を満たすため、これまでにもいくつかの材料が提案されている。

40

## 【0007】

例えば、無機系又は有機系シラン化合物の加水分解物及び/又は縮合物からなる中間層を設けることが提案されているが（特許文献1参照）、この中間層は、シラン化合物を含む塗布液を用いる関係上、成膜の際には、慣用のスピンドルローテーティング法を用いることができず、専用のコータートラックを用いなければならない上に、縮合反応の際に生じる副生成物を除去するために、300以上という高温での焼成を必要とし、また放射線に対する発色団を安定に導入することができないため、反射防止能力の付与がむずかしいなどの欠点を有している。

## 【0008】

また、誘電体層上に、周期表IIIA、IVA、Va、VIA、VIIA、VIII、

50

I b、I I b、I I I b、I V b 又はV b 族の中から選ばれた無機元素を含む有機反射防止ハードマスクも提案されているが（特許文献2参照）、このものも放射線に対する発色団の安定な導入ができないため、ケースバイケースにおいて必要な反射防止能力の調整ができないという欠点がある。

**【0009】**

【特許文献1】特開2002-40668号公報（特許請求の範囲等）

【特許文献2】特開2001-53068号公報（特許請求の範囲等）

**【発明の開示】**

**【発明が解決しようとする課題】**

**【0010】**

本発明は、有機溶剤に可溶で慣用のスピンコーティング法により簡単に塗布することができ、保存安定性がよく、しかも放射線を吸収する発色団を導入することにより、その反射防止能力の調整が可能な組成物を用いて形成させた反射防止膜を下地基板とレジスト膜との間に有するレジストパターン形成用材料を提供することを目的としてなされたものである。

**【課題を解決するための手段】**

**【0011】**

本発明者らは、レジスト膜と下地基板の間に設けることにより効率よく反射防止を行いうる中間層、いわゆる三層レジストプロセスのハードマスク材料について種々研究を重ねた結果、特定の組成をもつラダー型シリコーン共重合体と酸発生剤と架橋剤を含む組成物が有機溶剤に可溶で、慣用のスpinコーティング法により簡単に塗布することができ、かつ放射線を吸収する発色団の導入が容易で、適当に調整された反射防止能力をもつ安定な反射防止膜を形成しうることを見出し、この知見に基づいて本発明をなすに至った。

**【0012】**

すなわち、本発明は、下地基板とレジスト膜との間に反射防止膜を有するレジストパターン形成用材料において、反射防止膜が、(A)(a<sub>1</sub>) (ヒドロキシフェニルアルキル)シルセスキオキサン単位10~90モル%、(a<sub>2</sub>) (アルコキシフェニルアルキル)シルセスキオキサン単位0~50モル%及び(a<sub>3</sub>)フェニルシルセスキオキサン単位10~90モル%からなるラダー型シリコーン共重合体、(B)熱又は光により酸を発生する酸発生剤及び(C)架橋剤の有機溶剤溶液から形成された塗膜であって、0.002~0.95の範囲のArFレーザーに対する光学パラメーター(k値)を有するものであることを特徴とするレジストパターン形成用材料を提供するものである。

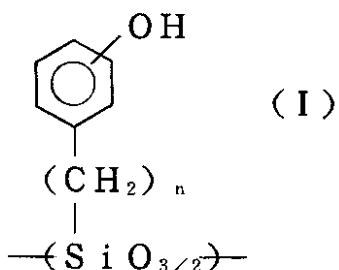
**【0013】**

本発明において反射防止膜形成のために用いる組成物は、(A)ラダー型シリコーン共重合体と、(B)熱又は光により酸を発生する酸発生剤と(C)架橋剤とを必須成分として含有するものである。

**【0014】**

そして、(A)成分のラダー型シリコーン共重合体としては、(a<sub>1</sub>) (ヒドロキシフェニルアルキル)シルセスキオキサン単位、すなわち、一般式

**【化1】**



又は

10

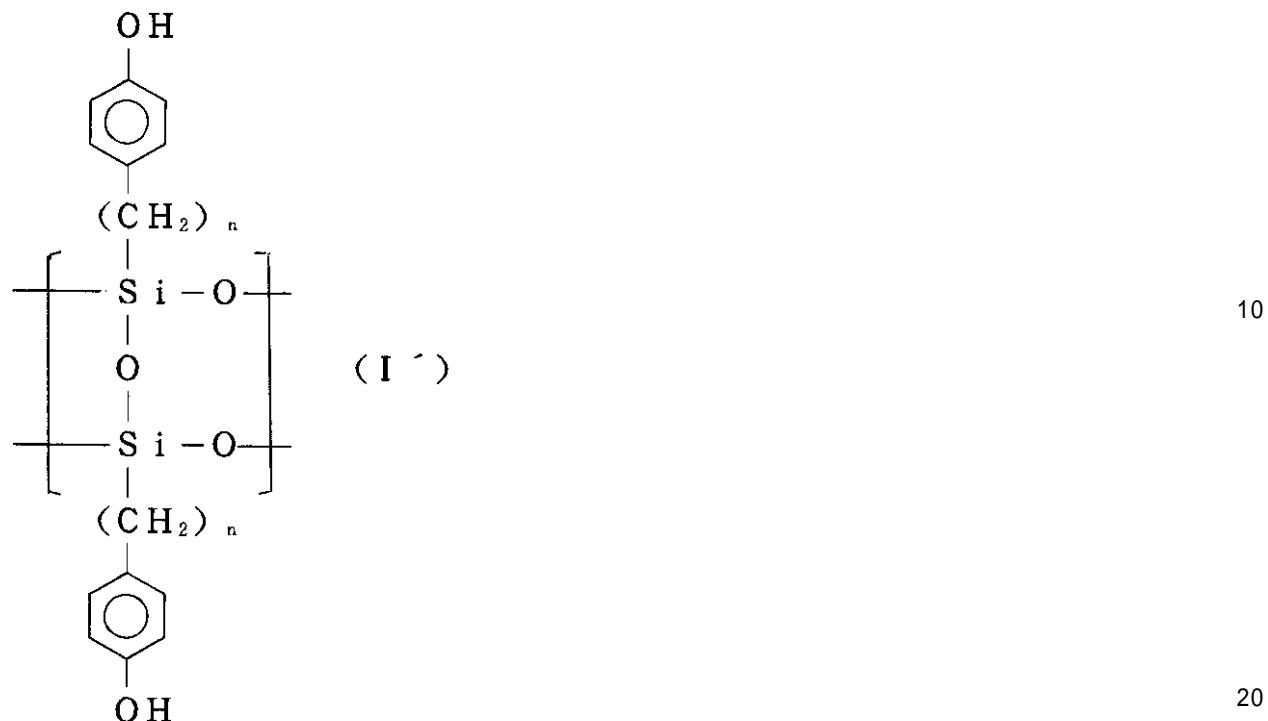
20

30

30

40

## 【化2】



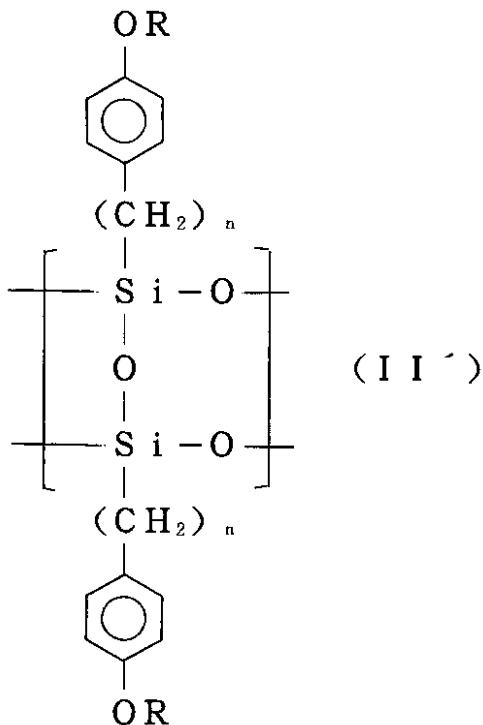
(式中のnは1~3の整数である)  
で表わされる構成単位10~90モル%と、(a<sub>2</sub>)（アルコキシフェニルアルキル）シリセスキオキサン単位、すなわち一般式

## 【化3】



又は

【化4】



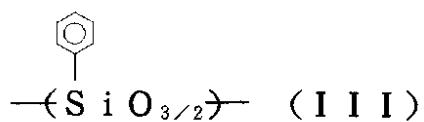
10

20

(式中の R は炭素数 1 ~ 4 の直鎖状又は枝分れ状低級アルキル基、 n は 1 ~ 3 の整数である)

で表わされる構成単位 0 ~ 50 モル%と、(a<sub>3</sub>) フェニルシリセスキオキサン単位、すなわち式

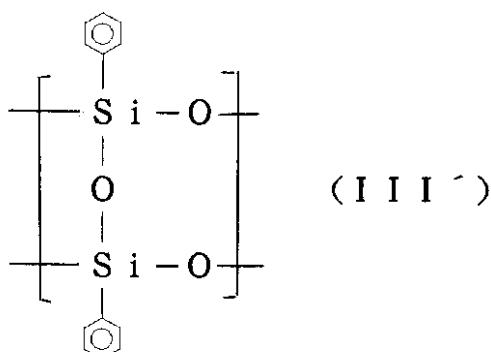
【化5】



30

又は

【化6】



40

で表わされる構成単位 10 ~ 90 モル%からなるラダー型シリコーン共重合体を用いることが必要である。上記一般式 (II) 又は (II') 中の R としては、メチル基が最も好ましい。また、上記一般式 (I) と (II) における -OH 基と -OR 基は、o 位、m 位及び p 位のいずれの位置に結合していくてもよいが、工業的には p 位に結合しているのが好ましい。また、(a<sub>1</sub>)、(a<sub>2</sub>) 及び (a<sub>3</sub>) 単位は、通常上記一般式 (I)、(II) 及び (III) で表わされたり、(I')、(II')、(III') と表わされたりす

50

るが、同じものである。

このラダー型シリコーン共重合体は、質量平均分子量（ポリスチレン換算）が1500～30000の範囲にあるものが好ましく、3000～20000の範囲にあるものが最も好ましい。分子量の分散度は1.0～5.0の範囲であることが好ましく、1.2～3.0であることが最も好ましい。

#### 【0015】

次に、(B)成分の熱又は光により酸を発生する酸発生剤は、通常化学增幅型レジスト組成物の成分として用いられている物質であり、本発明においては、これらの中から任意に選択して用いることができるが、特にオニウム塩、ジアゾメタン系化合物が好ましい。

#### 【0016】

このような酸発生剤としては、例えばジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート又はノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムのトリフルオロメタンスルホネート又はノナフルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート又はノナフルオロブタンスルホネート、トリ(4-メチルフェニル)スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート又はノナフルオロブタンスルホネートなどのオニウム塩や、ビス(p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(1,1-ジメチルエチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(2,4-ジメチルフェニルスルホニル)ジアゾメタンなどのジアゾメタン系化合物を挙げることができる。これらの中で特に好ましいのは、分解点250以下のおニウム塩例えばトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート、ビス(p-t-ブチルフェニル)ヨードニウムの7,7-ジメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン2オン1スルホン酸塩などである。

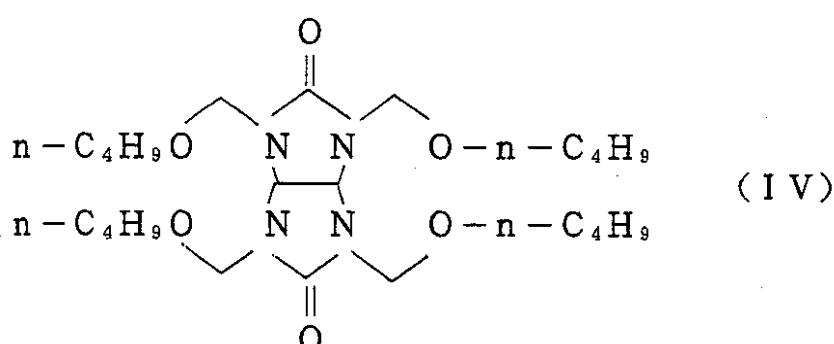
#### 【0017】

この(B)成分の酸発生剤は、単独で用いてもよいし、2種以上組み合わせて用いてもよい。その含有量は、前記(A)成分100質量部に対し、通常0.5～20質量部、好ましくは1～10質量部の範囲で選ばれる。この酸発生剤が0.5質量部未満では反射防止膜を形成しにくくなるし、20質量部を超えると均一な溶液とならず、保存安定性が低下する。

#### 【0018】

また、(C)成分の架橋剤は、本発明組成物を加熱又は焼成したときに(A)成分を架橋してハードマスク材として適切な被膜を形成しうるものであればよく、特に制限はないが、2個以上の反応性基をもつ化合物、例えばジビニルベンゼン、ジビニルスルホン、トリアクリルホルマール、グリオキザールや多価アルコールのアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステルや、メラミン、尿素、ベンゾグアナミン、グリコールウリルのアミノ基の少なくとも2個がメチロール基又は低級アルコキシメチル基で置換されたものが好ましい。その中でも、特に式

#### 【化7】



で表わされる2,4,6,8テトラ-n-ブトキシメチルビシクロ[1.0.1]

10

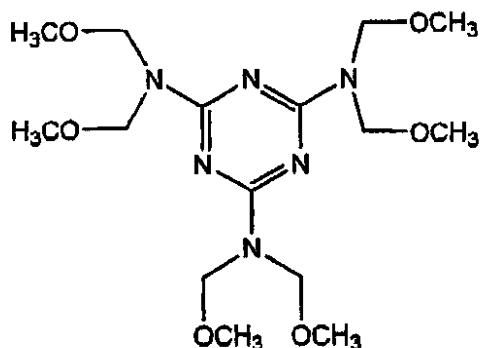
20

30

40

50

2, 4, 6, 8 テトラアザオクタン 3, 7 ジオンや、式  
【化 8】



10

で表わされるヘキサメトキシメチルメラミンが好ましい。

これらの架橋剤は、(A) 100質量部当り1~10質量部の範囲内で用いるのがよい。

【0019】

本発明において、反射防止膜を形成するために用いられる組成物は、上記の(A)成分、(B)成分及び(C)成分を有機溶剤に溶解して得られる溶液であるが、この際用いる有機溶剤としては、これら3成分の必要量を溶解しうるものの中から任意に選ぶことができるが、焼成条件を考慮すると沸点150以上の中ものが好ましい。この溶剤としては、例えばアセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、メチルイソアミルケトンなどのケトン類や、エチレングリコール、エチレングリコールモノアセテート、プロピレングリコール、プロピレングリコールモノアセテート、ジエチレングリコール又はジエチレングリコールモノアセテートのモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノブロピルエーテル、モノブチルエーテル又はモノフェニルエーテルなどの多価アルコール類及びその誘導体や、ジオキサンのような環式エーテル類や、乳酸メチル、乳酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチルなどのエステル類が用いられる。これらは単独で用いてもよいし、また2種以上混合して用いてもよい。

この有機溶剤は、固形分全質量に基づき1~20倍量、好ましくは2~10倍量の割合で使用される。

【0020】

本発明において、反射防止膜を形成するために用いられる組成物は、またArFレーザーすなわち波長193nmの光に対する光学パラメーター(k値)が0.002~0.95、好ましくは0.1~0.7、さらに好ましくは0.15~0.4の範囲内にある反射防止膜が形成されるように調整されることが必要である。この調整は、例えば(A)成分中の(a<sub>2</sub>)成分の含有割合を増減することによって行うことができる。このような範囲に調整することにより、反射防止膜の厚さを40~200nmにしたときに低く安定な反射率を示す。

【0021】

次に、本発明において、反射防止膜を形成するために用いられる組成物には、上記の(A)成分、(B)成分及び(C)成分に加え、必要に応じさらに(D)成分として線状ポリマーを含有させることができる。

【0022】

そして、この組成物において、(D)成分として用いる線状ポリマーは、少なくとも水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル単位を構成単位として含むポリマー、すなわち水酸基含有(メタ)アクリル酸エステルのホモポリマー又は水酸基含有(メタ)アクリル酸エステルと他の共重合可能なモノマーとのコポリマーであるのが好ましい。

【0023】

このように水酸基を含むポリマーを(D)成分として用いることにより、この水酸基が

20

30

40

50

架橋助剤として高分子量化を助長し、レジスト溶剤や現像液に対する安定性が著しく向上するという効果が奏される。この効果は、特に側鎖としてアダマンチル基のような脂肪族多環式基を有する水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルを用いたときに増大する。

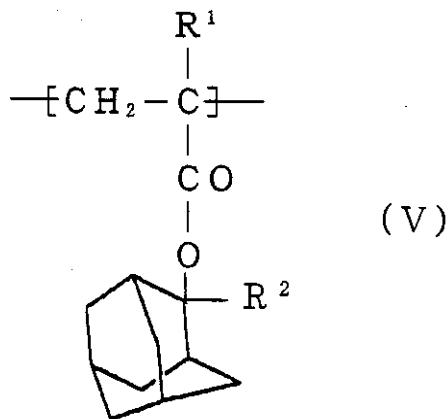
## 【0024】

この線状ポリマーが水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルのコポリマーの場合、水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルと共に重合させるモノマー成分としては特に制限はなく、従来ArFレジストに用いられている公知のモノマーの中から任意に選択して用いることができる。

## 【0025】

上記の水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル単位を含む線状ポリマーの中で特に好適なのは、（d<sub>1</sub>）一般式

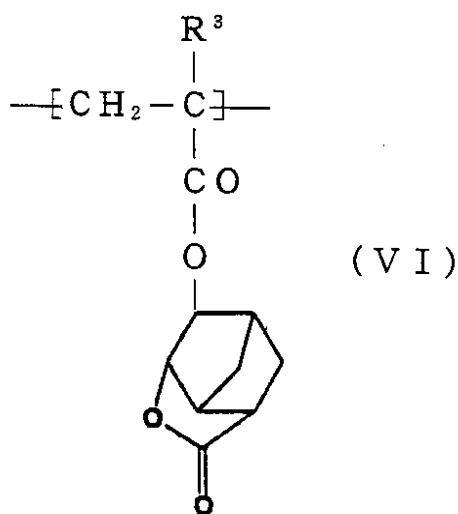
## 【化9】



10

20

（式中、R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基、R<sup>2</sup>は低級アルキル基である）  
で表わされる構成単位10～60モル%、好ましくは20～40モル%、（d<sub>2</sub>）一般式  
【化10】

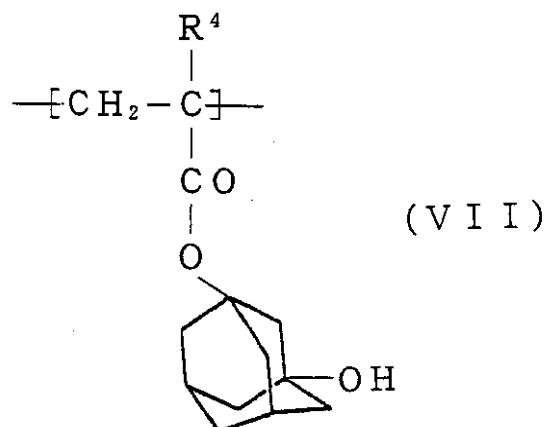


30

40

（式中のR<sup>3</sup>は水素原子又はメチル基である）  
で表わされる構成単位30～80モル%、好ましくは20～50モル%、及び（d<sub>3</sub>）一般式

## 【化11】



10

(式中、 $\text{R}^4$ は水素原子又はメチル基である)

で表わされる構成単位 10 ~ 50 モル%、好ましくは 20 ~ 40 モル% からなる線状共重合体を挙げることができる。

上記一般式 (V) 中の  $\text{R}^2$  としては、炭素数 1 ~ 5 の低級アルキル基、特にメチル基やエチル基が工業的な面から好ましい。

## 【0026】

20

この (D) 成分の線状ポリマーは、質量平均分子量 5000 ~ 20000 の範囲のものが好ましい。

この (D) 成分は、(A) 成分 100 質量部当り 10 ~ 100 質量部の割合で配合される。

## 【0027】

次に、本発明において、反射防止膜を形成するために用いられる組成物には、上記した (A) 成分、(B) 成分及び(C) 成分、場合により配合される (D) 成分に加えて、さらにその分散性及び塗膜均一性を付与するために慣用のイオン性又は非イオン性界面活性剤を含有させることができる。

## 【0028】

30

これらの界面活性剤は、固体分合計量 100 質量部当り 0.05 ~ 1.0 質量部の割合で添加される。

## 【0029】

本発明において、反射防止膜を形成するには、上記の組成物を、シリコンウエーハのような基板上に慣用のスピンコーティング法を用いて簡単に塗布することができ、所望厚さの反射防止膜を形成させることができる。これまでのレジストプロセスにおいては、蒸着により基板上に酸化膜を形成し、その上にレジスト膜を施すことが必要であったことを考えれば、非常に簡便化されていることが分る。

## 【0030】

40

この反射防止膜を形成するには、基板上に回転塗布し、乾燥後、溶剤の沸点以下、例えば 100 ~ 120 において、60 ~ 120 秒間、次いで 200 ~ 250 において、60 ~ 120 秒間加熱する多段階加熱法を用いるのがよい。このようにして、厚さ 40 ~ 200 nm の反射防止膜を形成したのち、常法によりこの上にレジスト膜を 100 ~ 300 nm の厚さで設けてレジスト材料を製造する。この場合、基板上に先ず 200 ~ 600 nm の厚さに有機膜を設け、その有機膜とレジスト膜の中間層として、上記の反射防止膜を形成させることにより、三層レジスト材料とすることもできる。

## 【0031】

上記 (A) 成分のラダー型シリコーン共重合体は、反射防止膜を形成するために用いられる組成物の基材樹脂成分、特に該組成物の ArF レーザーすなわち波長 193 nm の光に対する光学パラメーター (k 値) を 0.002 ~ 0.95 に調整する場合の成分として

50

重要であり、そのような調整を効果的に行うことができる。また、該共重合体におけるシリコン含有率が高く、O<sub>2</sub>プラズマ耐性が高く好ましい。

該ラダー型シリコーン共重合体はそれ自体公知の方法、例えば特許第2567984号公報の製造例1に記載の方法で合成できる。

#### 【0032】

また、(A)成分のラダー型シリコーン共重合体の中で、(ヒドロキシフェニルアルキル)シルセスキオキサン単位及びアルキルシルセスキオキサン単位の組合せを含む共重合体は文献未載の新規化合物である。これを反射防止膜を形成するために用いられる組成物に用いるには、(ヒドロキシフェニルアルキル)シルセスキオキサン単位とアルキルシルセスキオキサン単位との含有割合はモル比で10:90ないし90:10の範囲のものが好ましく、またその中でも質量平均分子量が1500~30000、特に3000~20000で、分散度が1.0~5.0、特に1.2~3.0の範囲にあるものが好ましい。  
10

#### 【発明の効果】

#### 【0033】

本発明によると、慣用のレジストコーティング法により、簡単に塗布することができ、保存安定性、酸素プラズマエッチング耐性がよく、優れたプロファイル形状のマスクパターンを与えることができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0034】

次に、実施例により本発明を実施するための最良の形態をさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によりなんら限定されるものではない。  
20

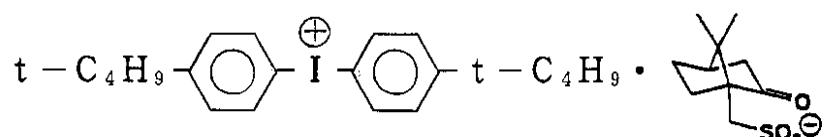
なお、各実施例においては、酸発生剤(B)成分、架橋剤(C)成分及び線状ポリマー(D)成分として以下に示す化合物を用いた。

#### 【0035】

(1) 酸発生剤；

(B)成分

#### 【化12】

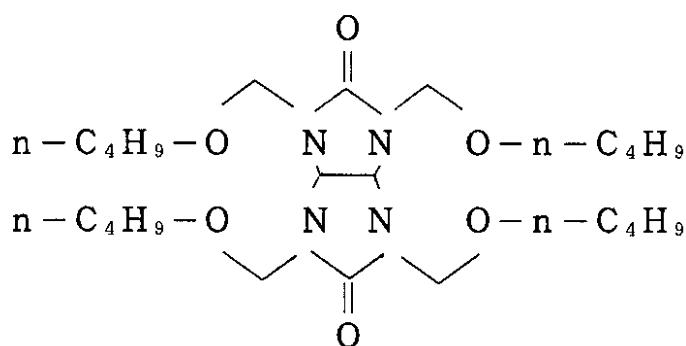


30

(2) 架橋剤；

(C<sub>1</sub>)成分

#### 【化13】

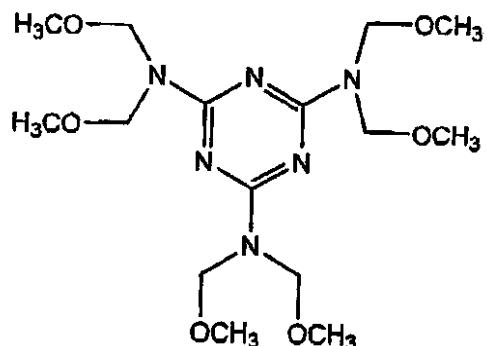


40

又は

(C<sub>2</sub>)成分

## 【化14】



10

(3) 線状ポリマー;

(D) 成分

2 エチル 2 アダマンチルアクリレート単位、一般式(VI)におけるR<sup>3</sup>が水素原子である単位及び3 ヒドロキシ 1 アダマンチルアクリレート単位をそれぞれ30モル%、40モル%及び30モル%含むアクリレートタイプポリマー  
質量平均分子量10000

## 【0036】

なお、各実施例における光学パラメーター(k値：消衰係数)は以下の方法により測定した数値である。

20

すなわち、試料を8インチシリコンウェーハ上に塗布して膜厚50nmの塗膜を形成させ、スペクトロスコピックエリプソメトリー( J . A . W O O L L A M 社製、「VUV-VASE」)により測定し、同社製の解析ソフトウェア(WVASE32)により解析した。

## 【0037】

## 参考例1

かきませ機、還流冷却器、滴下漏斗及び温度計を備えた500ml三つ口フラスコに、炭酸水素ナトリウム1.00モル(84.0g)と水400mlを投入し、次いで滴下漏斗からp-メトキシベンジルトリクロロシラン0.36モル(92.0g)とフェニルトリクロロシラン0.14モル(29.6g)とをジエチルエーテル100mlに溶かして得た溶液を2時間にわたってかきませながら滴下したのち、1時間加熱還流した。反応終了後、反応混合物から反応生成物をジエチルエーテルで抽出し、この抽出液からジエチルエーテルを減圧下に留去し、加水分解生成物を回収した。

30

このようにして得た加水分解生成物に10質量% - 水酸化カリウム水溶液0.33gを加え、200℃で2時間加熱することにより、p-メトキシベンジルシルセスキオキサン単位72モル%とフェニルシルセスキオキサン単位28モル%からなる共重合体A<sub>1</sub>(64.4g)を製造した。共重合体A<sub>1</sub>のプロトンNMR、赤外吸収スペクトル、GPC(ゲルパーキエーションクロマトグラフィー)の分析結果を以下に示す。

<sup>1</sup>H-NMR(DMSO-d<sub>6</sub>) : δ = 2.70 ppm(-CH<sub>2</sub>-), 3.50 ppm(-OCH<sub>3</sub>), 6.00~7.50 ppm(ベンゼン環)

40

IR(cm<sup>-1</sup>) : 1178(-OCH<sub>3</sub>), 1244, 1039(-SiO-)

質量平均分子量(Mw) : 7500、分散度(Mw/Mn) : 1.8

## 【0038】

次に、この共重合体A<sub>1</sub>をアセトニトリル150mlに溶解して得た溶液に、トリメチルシリルヨード0.4モル(80.0g)を加え、還流下で24時間かきませたのち、水50mlを加え、さらに12時間還流下でかきませて反応させた。冷却後、亜硫酸水素ナトリウム水溶液で遊離のヨウ素を還元したのち、有機層を分離し、溶媒を留去した。残留物をアセトンとn-ヘキサンで再沈し、減圧加熱乾燥することにより、p-ヒドロキシベンジルシルセスキオキサン単位72モル%とフェニルシルセスキオキサン単位28モル%からなる共重合体A<sub>2</sub>(39.0g)を製造した。共重合体A<sub>2</sub>のプロトンNMR、赤外吸

50

吸スペクトル、G P C (ゲルパーキエーションクロマトグラフィー)の分析結果を以下に示す。

<sup>1</sup>H - N M R (D M S O - d<sub>6</sub>) : = 2 . 7 0 p p m (- C H<sub>2</sub>-)、6 . 0 0 ~ 7 . 5 0 p p m (ベンゼン環)、8 . 9 0 p p m (- O H)  
 I R (c m<sup>-1</sup>) : = 3 3 0 0 (- O H)、1 2 4 4, 1 0 4 7 (- S i O -)  
 質量平均分子量 (Mw) : 7 0 0 0、分散度 (Mw / Mn) : 1 . 8

### 【0039】

#### 参考例 2

参考例 1で製造した共重合体A<sub>1</sub>をアセトニトリル150m lに溶解して得た溶液に、トリメチルシリルヨード0 . 2 5 0 モル(50 . 0 g)を加え、還流下で24時間かきませたのち、水50m lを加え、さらに12時間還流下でかきませて反応させた。冷却後、亜硫酸水素ナトリウム水溶液で遊離のヨウ素を還元したのち、有機層を分離し、溶媒を留去した。残留物をアセトンとn ヘキサンで再沈し、減圧加熱乾燥することにより、p ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位36モル%とp メトキシベンジルシリセスキオキサン単位36モル%とフェニルシリセスキオキサン単位28モル%からなる共重合体A<sub>3</sub>(40 . 3 g)を製造した。共重合体A<sub>3</sub>のプロトンN M R、赤外吸収スペクトル、G P C (ゲルパーキエーションクロマトグラフィー)の分析結果を以下に示す。  
 10

<sup>1</sup>H - N M R (D M S O - d<sub>6</sub>) : = 2 . 7 0 p p m (- C H<sub>2</sub>-)、3 . 5 0 p p m (- O C H<sub>3</sub>)、6 . 0 0 ~ 7 . 5 0 p p m (ベンゼン環)、8 . 9 0 p p m (- O H)  
 I R (c m<sup>-1</sup>) : = 3 3 0 0 (- O H)、1 1 7 8 (- O C H<sub>3</sub>)、1 2 4 4, 1 0 4 7 (- S i O -)  
 20

質量平均分子量 (Mw) : 7 0 0 0、分散度 (Mw / Mn) : 1 . 8

### 【0040】

#### 参考例 3

参考例 1で製造した共重合体A<sub>1</sub>をアセトニトリル150m lに溶解して得た溶液に、トリメチルシリルヨード0 . 3 4 7 モル(69 . 4 g)を加え、還流下で24時間かきませたのち、水50m lを加え、さらに12時間還流下でかきませて反応させた。冷却後、亜硫酸水素ナトリウム水溶液で遊離のヨウ素を還元したのち、有機層を分離し、溶媒を留去した。残留物をアセトンとn ヘキサンで再沈し、減圧加熱乾燥することにより、p ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位50モル%とp メトキシベンジルシリセスキオキサン単位22モル%とフェニルシリセスキオキサン単位28モル%からなる共重合体A<sub>4</sub>(39 . 8 g)を製造した。共重合体A<sub>4</sub>のプロトンN M R、赤外吸収スペクトル、G P C (ゲルパーキエーションクロマトグラフィー)の分析結果を以下に示す。  
 30

<sup>1</sup>H - N M R (D M S O - d<sub>6</sub>) : = 2 . 7 0 p p m (- C H<sub>2</sub>-)、3 . 5 0 p p m (- O C H<sub>3</sub>)、6 . 0 0 ~ 7 . 5 0 p p m (ベンゼン環)、8 . 9 0 p p m (- O H)  
 I R (c m<sup>-1</sup>) : = 3 3 0 0 (- O H)、1 1 7 8 (- O C H<sub>3</sub>)、1 2 4 4, 1 0 4 7 (- S i O -)  
 40

質量平均分子量 (Mw) : 7 0 0 0、分散度 (Mw / Mn) : 1 . 8

### 【0041】

#### 参考例 4

かきませ機、還流冷却器、滴下漏斗及び温度計を備えた500m l三つ口フラスコに、炭酸水素ナトリウム1 . 0 0 モル(84 . 0 g)と水400m lを投入し、次いで滴下漏斗からp メトキシベンジルトリクロロシラン0 . 3 6 モル(92 . 0 g)とn プロピルトリクロロシラン0 . 1 4 モル(24 . 9 g)とをジエチルエーテル100m lに溶かして得た溶液を2時間にわたってかきませながら滴下したのち、1時間加熱還流した。反応終了後、反応生成物をジエチルエーテルで抽出し、抽出液からジエチルエーテルを減圧下に留去した。

このようにして得た加水分解生成物に10質量% - 水酸化カリウム水溶液0 . 3 3 gを加え、200 度2時間加熱することにより、p メトキシベンジルシリセスキオキサン単位72モル%とn プロピルシリセスキオキサン単位28モル%からなる共重合体A<sub>5</sub>  
 50

(60.6 g) を製造した。共重合体 A<sub>5</sub> のプロトン NMR、赤外吸収スペクトル、GPC (ゲルパーキエーションクロマトグラフィー) の分析結果を以下に示す。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>) : δ = 1.00 ~ 2.00 ppm (-n-Propyl)、2.70 ppm (-CH<sub>2</sub>-)、3.50 ppm (-OCH<sub>3</sub>)、6.00 ~ 7.50 ppm (ベンゼン環)

IR (cm<sup>-1</sup>) : ν = 1178 (-OCH<sub>3</sub>)、1244, 1039 (-SiO-)

質量平均分子量 (Mw) : 7500、分散度 (Mw/Mn) : 1.8

#### 【0042】

次に、この共重合体 A<sub>5</sub> をアセトニトリル 150 ml に溶解して得た溶液に、トリメチルシリルヨード 0.4 モル (80.0 g) を加え、還流下で 24 時間かきませたのち、水 50 ml を加え、さらに 12 時間還流下でかきませて反応させた。冷却後、亜硫酸水素ナトリウム水溶液で遊離のヨウ素を還元したのち、有機層を分離し、溶媒を留去した。残留物をアセトンと n-ヘキサンで再沈し、減圧加熱乾燥することにより、p-ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位 72 モル% と n-プロピルシリセスキオキサン単位 28 モル% からなる共重合体 A<sub>6</sub> (36.6 g) を製造した。共重合体 A<sub>6</sub> のプロトン NMR、赤外吸収スペクトル、GPC (ゲルパーキエーションクロマトグラフィー) の分析結果を以下に示す。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>) : δ = 1.00 ~ 2.00 ppm (-n-Propyl)、2.70 ppm (-CH<sub>2</sub>-)、6.00 ~ 7.50 ppm (ベンゼン環)、8.90 ppm (-OH)

IR (cm<sup>-1</sup>) : ν = 3300 (-OH)、1244, 1047 (-SiO-)

質量平均分子量 (Mw) : 7000、分散度 (Mw/Mn) : 1.8

#### 【0043】

##### 参考例 5

かきませ機、還流冷却器、滴下漏斗及び温度計を備えた 500 ml 三つ口フラスコに、炭酸水素ナトリウム 1.00 モル (84.0 g) と水 400 ml を投入し、次いで滴下漏斗から p-メトキシベンジルトリクロロシラン 0.32 モル (81.8 g) とフェニルトリクロロシラン 0.18 モル (38.1 g) とをジエチルエーテル 100 ml に溶かして得た溶液を 2 時間にわたってかきませながら滴下したのち、1 時間加熱還流した。反応終了後、反応生成物をジエチルエーテルで抽出し、抽出液からジエチルエーテルを減圧下に留去した。

このようにして得た加水分解生成物に 10 質量% - 水酸化カリウム水溶液 0.33 g を加え、200 度で 2 時間加熱することにより、p-メトキシベンジルシリセスキオキサン単位 64 モル% とフェニルシリセスキオキサン単位 36 モル% からなる共重合体 A<sub>7</sub> (62.9 g) を製造した。共重合体 A<sub>7</sub> のプロトン NMR、赤外吸収スペクトル、GPC (ゲルパーキエーションクロマトグラフィー) の分析結果を以下に示す。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>) : δ = 2.70 ppm (-CH<sub>2</sub>-)、3.50 ppm (-OCH<sub>3</sub>)、6.00 ~ 7.50 ppm (ベンゼン環)

IR (cm<sup>-1</sup>) : ν = 1178 (-OCH<sub>3</sub>)、1244, 1039 (-SiO-)

質量平均分子量 (Mw) : 7500、分散度 (Mw/Mn) : 1.8

#### 【0044】

次に、この共重合体 A<sub>7</sub> をアセトニトリル 150 ml に溶解して得た溶液に、トリメチルシリルヨード 0.4 モル (80.0 g) を加え、還流下で 24 時間かきませたのち、水 50 ml を加え、さらに 12 時間還流下でかきませて反応させた。冷却後、亜硫酸水素ナトリウム水溶液で遊離のヨウ素を還元したのち、有機層を分離し、溶媒を留去した。残留物をアセトンと n-ヘキサンで再沈し、減圧加熱乾燥することにより、p-ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位 64 モル% とフェニルシリセスキオキサン単位 36 モル% からなる共重合体 A<sub>8</sub> (38.4 g) を製造した。共重合体 A<sub>8</sub> のプロトン NMR、赤外吸収スペクトル、GPC (ゲルパーキエーションクロマトグラフィー) の分析結果を以下に示す。

10

20

30

40

50

<sup>1</sup>H - NMR (DMSO-d<sub>6</sub>) : δ = 2.70 ppm (-CH<sub>2</sub>-), 6.00~7.50 ppm (ベンゼン環)、8.90 ppm (-OH)  
 IR (cm<sup>-1</sup>) : ν = 3300 (-OH)、1244, 1047 (-SiO-)  
 質量平均分子量 (Mw) : 7000、分散度 (Mw/Mn) : 1.8

#### 【実施例1】

##### 【0045】

ラダー型シリコーン共重合体すなわち(A)成分として、p-ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位72モル%とフェニルシリセスキオキサン単位28モル%からなる参考例1の共重合体A<sub>2</sub>(質量平均分子量7000)を用い、この(A)成分83質量部と上記酸発生剤として(B)成分3質量部と架橋剤として(C<sub>1</sub>)成分5質量部とを加え、さらに(D)成分として上記アクリレートタイプポリマー17質量部を加えて得た混合物を、プロピレングリコールモノプロピルエーテル300質量部に溶解して、反射防止膜形成用組成物を調製した。  
 10

次に、シリコンウェーハ上に慣用のレジストコーティング装置を用いて上記の組成物を塗布し、100℃で90秒、続いて250℃で90秒の条件下で2段階の加熱処理を行うことにより、厚さ55nmの反射防止膜を形成させた。

この反射防止膜の光学パラメーター(k値)は0.67であった。

このようにして異なった厚さの塗膜を形成させ、厚さに対する反射率を測定し、グラフとして図1に示す。

この図から分るように、k値が0.67の場合、使用膜厚範囲40~150nmにおいて安定な低反射率を示す。  
 20

#### 【実施例2】

##### 【0046】

(A)成分として、p-ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位36モル%とp-メトキシベンジルシリセスキオキサン単位36モル%とフェニルシリセスキオキサン単位28モル%からなる参考例2の共重合体A<sub>3</sub>(質量平均分子量7000)を用い、この(A)成分100質量部と酸発生剤として前記(B)成分3質量部と架橋剤として前記(C<sub>1</sub>)成分5質量部とを、プロピレングリコールモノメチルエーテルモノアセテートとプロピレングリコールモノメチルエーテルとの混合物(質量比40/60)300質量部に溶解することにより反射防止膜形成用組成物を調製した。  
 30

次に、シリコンウェーハ上に慣用のレジストコーティング装置を用いて上記の組成物を塗布し、100℃で90秒、続いて250℃で90秒の条件下で2段階で加熱処理を行うことにより、厚さ約50nmの反射防止膜を形成させた。

この反射防止膜の光学パラメーター(k値)は0.67であった。

#### 【実施例3】

##### 【0047】

(A)成分として、p-ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位50モル%とp-メトキシベンジルシリセスキオキサン単位22モル%とフェニルシリセスキオキサン単位28モル%からなる参考例3の共重合体A<sub>4</sub>(質量平均分子量7000)を用い、この(A)成分100質量部と酸発生剤として前記(B)成分3質量部と架橋剤として前記(C<sub>1</sub>)成分5質量部とを、プロピレングリコールモノメチルエーテルモノアセテート300質量部に溶解することにより反射防止膜形成用組成物を調製した。  
 40

この組成物を、実施例1と同様にしてシリコンウェーハ上に塗布し、100℃で90秒間加熱後、230℃で90秒間加熱することにより、厚さ70nmの反射防止膜を形成させた。この反射防止膜の光学パラメーター(k値)は0.90であった。

#### 【実施例4】

##### 【0048】

加熱処理を250℃で90秒間の1段階での加熱処理に変えた以外は、実施例3と全く同様にして厚さ70nmの反射防止膜を形成させた。

この反射防止膜の光学パラメーター(k値)は0.90であった。  
 50

## 【実施例 5】

## 【0049】

(A) 成分として、参考例4で得た共重合体A<sub>6</sub>83質量部と酸発生剤として前記(B)成分3質量部と架橋剤として前記(C<sub>1</sub>)成分5質量部とを加え、さらに線状ポリマーとして前記(D)成分17質量部を加えて得た混合物を、プロピレングリコールモノプロピルエーテル300質量部に溶解して、反射防止膜形成用組成物を調製した。次に、シリコンウエーハ上に慣用のレジストコーティング装置を用いて上記の組成物を塗布し、100で90秒、続いて250で90秒の条件下で2段階で加熱処理を行うことにより、厚さ55nmの反射防止膜を形成させた。

この反射防止膜の光学パラメーター(k値)は0.55であった。

10

## 【実施例 6】

## 【0050】

(A) 成分として、p-ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン単位64モル%とフェニルシリセスキオキサン単位36モル%からなる参考例5の共重合体A<sub>8</sub>(質量平均分子量7000)を用い、この(A)成分83質量部と酸発生剤として前記(B)成分3質量部と架橋剤として前記(C<sub>2</sub>)成分5質量部とを加え、さらに線状ポリマーとして前記(D)成分17質量部を加えて得た混合物を、プロピレングリコールモノプロピルエーテル300質量部に溶解して、反射防止膜形成用組成物を調製した。次に、シリコンウエーハ上に慣用のレジストコーティング装置を用いて上記の組成物を塗布し、100で90秒、続いて250で90秒の条件下で2段階で加熱処理を行うことにより、厚さ75nmの反射防止膜を形成させた。

20

この反射防止膜の光学パラメーター(k値)は0.49であった。

## 【0051】

## 比較例

反射防止膜形成用組成物として、市販のテトラアルコキシシランとメチルトリアルコキシシランの共加水分解物と縮合物の混合物を主体とする塗布液(東京応化工業社製、商品名「OCD T-7 ML02」)を用い、これをSOG専用コーティング装置によりシリコンウエーハ上に塗布し、80で90秒、次に150で90秒、最後に250で90秒の条件下、3段階で加熱処理することにより、厚さ50nmの反射防止膜を形成させた。

上記の塗布液は溶液の乾燥に伴い、即座に粉状の析出物を生じ、これがコーティングノズル、コーティングカップ、ウェーハなどのコンタミネーションとなるため、慣用のレジストコーティング装置では、塗布不可能であった。

30

## 【0052】

## 応用例

前記した各実施例及び比較例における反射防止膜形成用組成物について、以下の方法により保存安定性、レジストコーティング装置による塗布可能性及び酸素プラズマエッティング耐性を試験し、その結果を表1に示した。

## 【0053】

## (1) 保存安定性(膜厚の変化)；

所定の組成物を室温下(20)又は冷凍下(-20)で45日間保存したものを準備し、それぞれ8インチシリコンウエーハ上に同じ塗布条件で回転塗布し、乾燥して塗膜を形成させたときのそれぞれの膜厚を測定し、冷凍保存試料に対する室温保存試料の膜厚の差が5%以内の場合を√、それよりも大きい場合を×とした。

40

## 【0054】

## (2) 保存安定性(粒子の発生)；

また、(1)の室温保存の試料について、粒径0.22μm以上の粒子の発生数をパーティクルカウンター[リオン(Rion)社製、製品名「パーティクルセンサーKS-41」]で測定し、300個以下の場合を√、それを超える場合を×として評価した。

## 【0055】

## (3) レジストコーティング装置による塗布可能性；

50

レジストコーティングで塗布可能なためには、エッジリニンス工程及びオートディスペンス工程で粒子の発生がないことが必要である。したがって、エッジリニンス液として用いられるプロピレングリコールメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル及び乳酸エチルに対して溶解させ、粒子の発生の有無を観察し、発生がない場合を、発生した場合を×と評価した。

## 【0056】

(4) 酸素プラズマエッティング耐性(エッティングレート)；

試料を以下の条件でエッティングし、そのエッティングレートを求めた。この数値が小さいほど酸素プラズマエッティング耐性が良好である。

エッティング装置；G P - 12 (東京応化工業社製、酸素プラズマエッティング装置) 10

エッティングガス；O<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> (60 / 40 sccm)

圧力；0.4 Pa

出力；1600 W

バイアスパワー；150 W

ステージ温度；-10

## 【0057】

【表1】

| 例   | 物性    |       |                 |                      |
|-----|-------|-------|-----------------|----------------------|
|     | 保存安定性 |       | レジストコーティングの使用可否 | 酸素プラズマエッティング耐性(nm/s) |
| 実施例 | 膜厚の変化 | 粒子の発生 |                 |                      |
|     | 1     | ○     | ○               | 0.15                 |
|     | 2     | ○     | ○               | 0.15                 |
|     | 3     | ○     | ○               | 0.15                 |
|     | 4     | ○     | ○               | 0.15                 |
|     | 5     | ○     | ○               | 0.14                 |
| 比較例 | 6     | ○     | ○               | 0.13                 |
|     | 比較例   | ×     | ×               | 0.063                |

10

20

30

## 【産業上の利用可能性】

## 【0058】

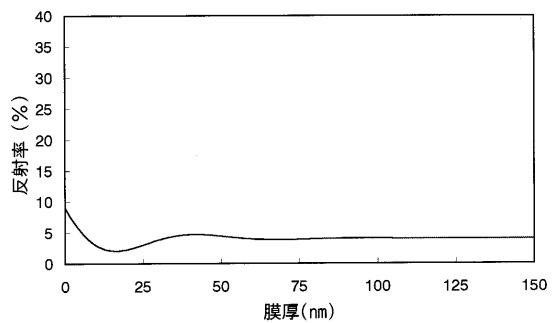
本発明のレジストパターン形成用材料は、半導体デバイスの製造用として好適である。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0059】

【図1】光学パラメーター(k値)0.67の本発明組成物についての膜厚と反射率との関係を示すグラフ。

【図1】



---

フロントページの続き

(72)発明者 川名 大助  
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

(72)発明者 田村 弘毅  
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

(72)発明者 佐藤 和史  
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

審査官 中村 博之

(56)参考文献 国際公開第02/091083(WO, A1)  
米国特許第06340734(US, B1)  
特開平05-323609(JP, A)  
特表2003-502449(JP, A)  
特開2002-040668(JP, A)  
特開2002-072489(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 03 F 7 / 00 - 7 / 42